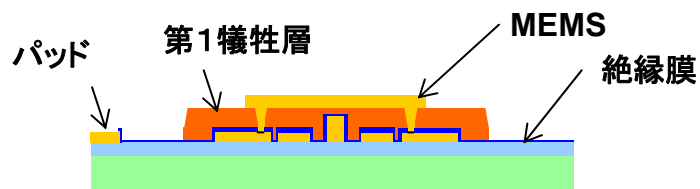
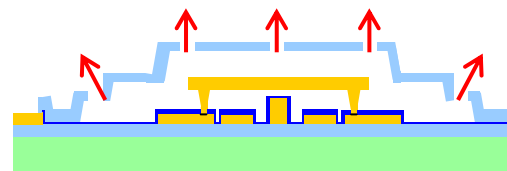


# 実圧気密方式によるパッケージ作製プロセス (工程:a→b→c→d→e→f)

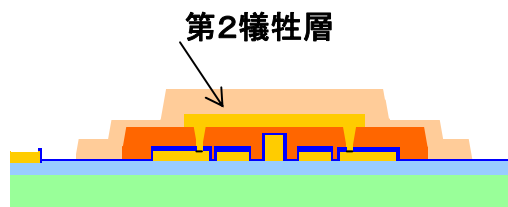
(a) MEMS 形成



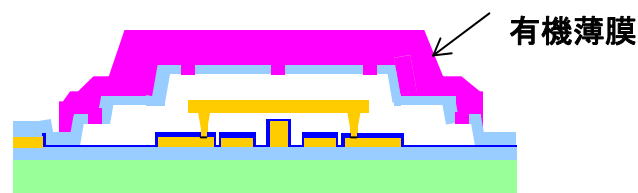
(d) ドライエッチングによる犠牲層除去



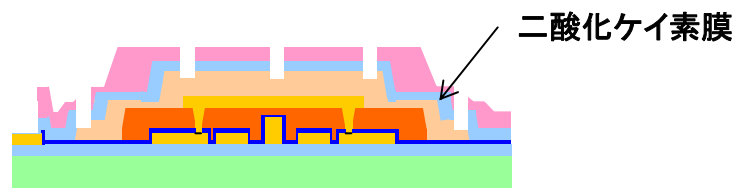
(b) 犠牲層パターニング



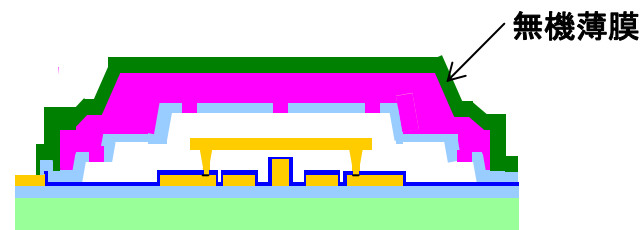
(e) 封止とパッド開口



(c) SiO<sub>2</sub> キャップ成膜と開口孔形成

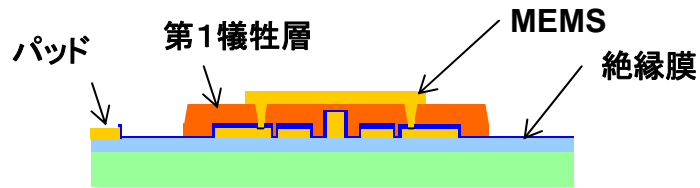


(f) 耐水性キャップ形成とパッド開口

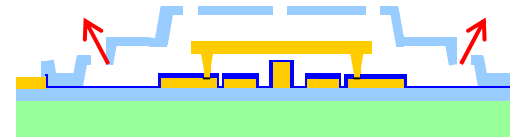


# 真空気密方式によるパッケージ作製プロセス (工程:a→b→c→d→e)

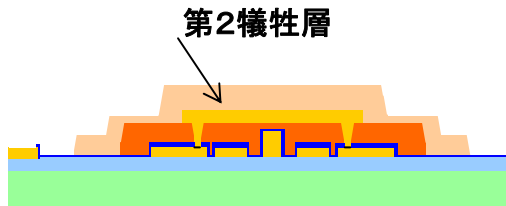
(a) MEMS 形成



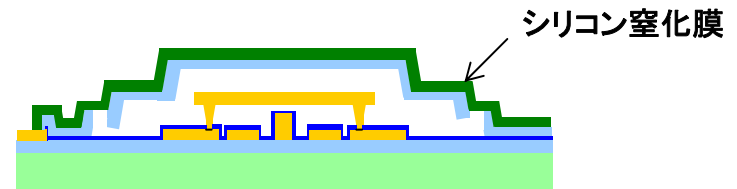
(d) ドライエッチングによる犠牲層除去



(b) 犠牲層パターニング



(e) 封止とパッド開口



(c) SiO<sub>2</sub> キャップ成膜と開口孔形成

